

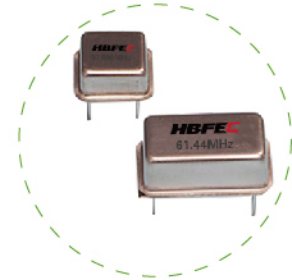
## 插装系列压控晶体振荡器

### 产品特性:

- 典型DIP14/DIP8封装
- 宽温度范围可达105℃
- LVCMOS/ Sine Wave 输出
- 低相噪
- 宽频率范围：5MHz~170MHz
- 可定制

### 应用范围:

- 高速Gbit 以太网
- 光纤通道
- SONET 企业服务
- SAS/SATA/DAP
- FPGA/微处理器



### 技术规范

|       |  |   |           |
|-------|--|---|-----------|
| 频率稳定度 | ≤ ± 50ppm (包含频率准确度@25℃, 工作温度范围内温度稳定度, 电压波动, 负载波动, 第一年老化, 冲击, 振动) |   |           |
| 电源电流  | 5~60MHz  | ≤ 25mA  |           |
|       | 60~170MHz  | ≤ 50mA  |           |
| 相位噪声  | -135dBc/Hz@1KHz(以100MHz为例)                                       |   |           |
| 开机时间  | ≤ 3mS  |   |           |
| 输出    |  | LVCMOS  | Sine Wave |
|       | 负载   | 15 pF   | 50Ω       |
|       | 电平   | $V_{OH} \geq 0.9V_{CC}$ $V_{OL} \leq 0.1V_{CC}$ | 0~10dBm   |

表 1

| 工作温度范围 |           |
|--------|-----------|
| A      | 0℃~70℃    |
| B      | -20℃~70℃  |
| C      | -40℃~85℃  |
| D      | -30℃~85℃  |
| E      | -40℃~105℃ |
| F      | -55℃~95℃  |
| G      | 定制        |

### 订货指南

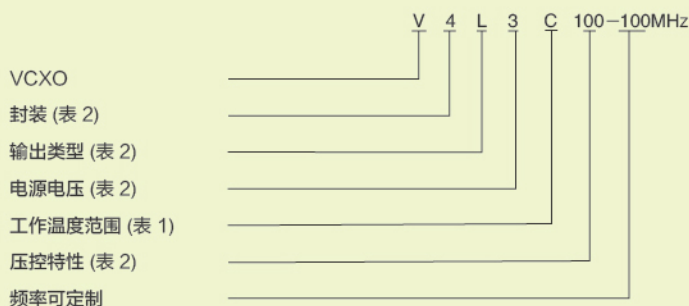


表 2

| 封装 |       | 输出类型 |           | 电源电压 |      |
|----|-------|------|-----------|------|------|
| 4  | DIP14 | L    | LVCMOS    | 3    | 3.3V |
| 8  | DIP8  | S    | Sine Wave | 5    | 5.0V |

| 压控特性 |          |
|------|----------|
| 100  | ± 50ppm  |
| 120  | ± 60ppm  |
| 160  | ± 80ppm  |
| 200  | ± 100ppm |

注：封装尺寸及引脚功能详见 21~25

# 压控晶体振荡器

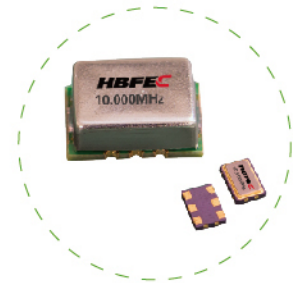
## 表贴系列压控晶体振荡器

### 产品特性:

- 典型 SMD陶瓷封装
- 宽频率范围 5MHz~1500MHz
- LVCMOS/ Sine Wave/LVPECL/LVDS
- 三态启用/禁用
- 频率可定制

### 应用范围:

- 高速Gbit 以太网
- 光纤通道
- 输出SONET 企业服务
- SAS/SATA/DAP
- FPGA/ 微处理器



### 技术规范

|       |   |  |           |   |  |
|-------|---|--|-----------|---|--|
| 频率稳定度 | ≤ ±50ppm (包含频率准确度@25℃, 工作温度范围内温度稳定度, 电压波动, 负载波动, 第一年老化, 冲击, 振动) |  |           |   |  |
| 电源电流  | LVCMOS  | ≤50mA  |           |   |  |
|       | Sine Wave   | ≤50mA  |           |   |  |
|       | LVPECL  | ≤100mA   |           |   |  |
|       | LVDS  | ≤70mA  |           |   |  |
| 相位噪声  | -128dBc/Hz@1KHz(以100MHz为例)                                      |  |           |   |  |
| 开机时间  | ≤3mS  |  |           |   |  |
| 输出    |   | LVCMOS   | Sine Wave | LVPECL  | LVDS   |
|       | 负载  | 15 pF  | 50Ω       | 50Ω   | 100Ω   |
|       | Level (V <sub>CC</sub> =3.3V)                                   | V <sub>OH</sub> ≥0.9V <sub>CC</sub><br>V <sub>OL</sub> ≤0.1V <sub>CC</sub> | 0~10dBm   | V <sub>OH</sub> ≥2.275V<br>V <sub>OL</sub> ≤1.68V | V <sub>OH</sub> ≤1.6V<br>V <sub>OL</sub> ≥0.9V |

表 1

| 工作温度范围 |           |
|--------|-----------|
| A      | 0℃~70℃    |
| B      | -20℃~70℃  |
| C      | -40℃~85℃  |
| D      | -30℃~85℃  |
| E      | -40℃~105℃ |
| F      | -55℃~95℃  |
| G      | 定制        |

### 订货指南

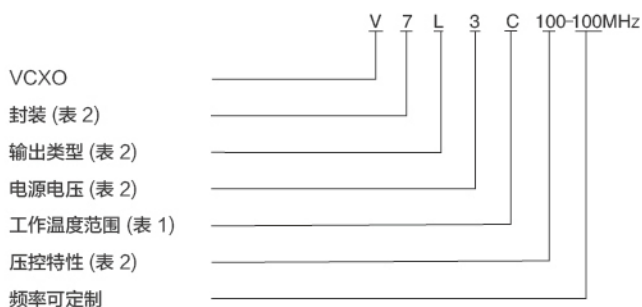


表 2

| 封装 |      |
|----|------|
| 5  | 5032 |
| 7  | 7050 |
| 9  | 9x14 |

| 输出类型 |           |
|------|-----------|
| L    | LVCMOS    |
| S    | Sine Wave |
| P    | LVPECL    |
| D    | LVDS      |

| 电源电压 |      |
|------|------|
| 2    | 2.5V |
| 3    | 3.3V |
| 5    | 5.0V |

| 压控特性 |         |
|------|---------|
| 100  | ±50ppm  |
| 120  | ±60ppm  |
| 160  | ±80ppm  |
| 200  | ±100ppm |

注: 封装尺寸及引脚功能详见 21~25.